








	<h2 style="color: red;">SI5509DC-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI5509DC-T1-GE3</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N/P-CH 20V 6.1A 1206-8</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI5509DC-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI5509DC-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N/P-CH 20V 6.1A 1206-8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	1206-8 ChipFET™
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	52 mOhm @ 5A, 4.5V
Leistung - max	4.5W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SMD, Flat Lead
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	455pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6.6nC @ 5V
Typ FET	N and P-Channel
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.1A, 4.8A

SI5509DC-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI5509DC-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI5509DC-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI5509DC-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI5511DC-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N/P-CH 30V 4A 1206-8</p>	 <p><b>SI5504DC-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N/P-CH 30V 2.9A 1206-8</p>	 <p><b>SI5509DC-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET N/P-CH 20V 6.1A 1206-8</p>	 <p><b>SI5504DC-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET N/P-CH 30V 2.9A 1206-8</p>
 <p><b>SI5509DC-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 20V 6.1A 1206-8</p>	 <p><b>SI5504DC-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 30V 2.9A 1206-8</p>	 <p><b>SI5509DC-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 20V 6.1A 1206-8</p>	 <p><b>SI5511DC-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 30V 4A 1206-8</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI5509DC-T1-GE3 Vishay / Siliconix	SI5509DC-T1-GE3 Datenblatt	SI5509DC-T1-GE3-Datenblätter	SI5509DC-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SI5509DC-T1-GE3
SI5509DC-T1-GE3 Electronic	SI5509DC-T1-GE3-Komponenten	SI5509DC-T1-GE3-Verteiler	SI5509DC-T1-GE3-Bild	SI5509DC-T1-GE3-Teil
SI5509DC-T1-GE3 Preis	SI5509DC-T1-GE3 Hersteller	SI5509DC-T1-GE3 Bild	SI5509DC-T1-GE3 Aktie	SI5509DC-T1-GE3 Inventar
SI5509DC-T1-GE3 Neu	SI5509DC-T1-GE3 Original	SI5509DC-T1-GE3 garantiert	SI5509DC-T1-GE3 RFQ	SI5509DC-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited